



MKC75

快速晶闸管模块

特点

芯片与底板电气绝缘，2500V交流绝缘
优良的温度特性和功率循环能力
体积小，重量轻

典型应用

逆变器
感应加热
斩波器

$I_{T(AV)}$	75	A
V_{DRM}/V_{RRM}	600-1600	V
I_{TSM}	2.0	KA
I^2T	20.4	KA ² S

符号		参数	测试条件	结温 $T_{J(c)}$	参数值	单位
电流额定值	$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $Ths=82^\circ C$	115	75	A
	$I_{T(RMS)}$	方均根电流			118	A
	I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,		2.00	KA
	I^2t	浪涌电流平方时间积	$VR=0.6V_{RRM}$		20.4	KA ² S
特性值	V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM}&V_{RRM} tp=10ms$	115	600-1600	V
	V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM}&V_{RSM}= V_{DRM}&V_{RRM}+100V$		30	Ma
	I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$		MAX0.85	V
	I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$		MAX2.20	V
	V_{TO}	门槛电压		25	4.88	$m\Omega$
	V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=225A,$		20-150	ma
	r_T	斜率电阻			MIN2500	V
	I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$		800	$V/\mu s$
动态参数	dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	25	200	$A/\mu s$
	di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=225A, tr \leq 1\mu s \quad IGM=1.5A$		15-35	μs
	tq	电流换相关断时间	$I_{TM}=75A, T_p=1000\mu s, V_R=50V$ $dv/dt=30/\mu s, di/dt=20A/\mu s$		30-150	Ma
门极特性	I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	1.0-2.5	v
	V_{GT}	门极触发电压			MIN2.0	V
	V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	115	0.200	$^\circ C/W$
热和机械数据	$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦半波, 单面散热	25	0.08	$^\circ C/W$
	$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热		6	$N \cdot m$
	F_m	安装扭矩 (M6)		6	-40--125	℃
		安装扭矩 (M6)			320	g
	T_{stg}	贮存温度				
	W_t	质量				

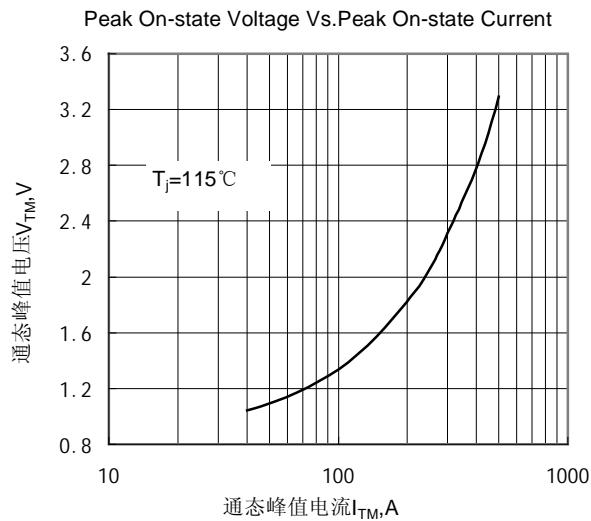


Fig.1 通态伏安特性曲线

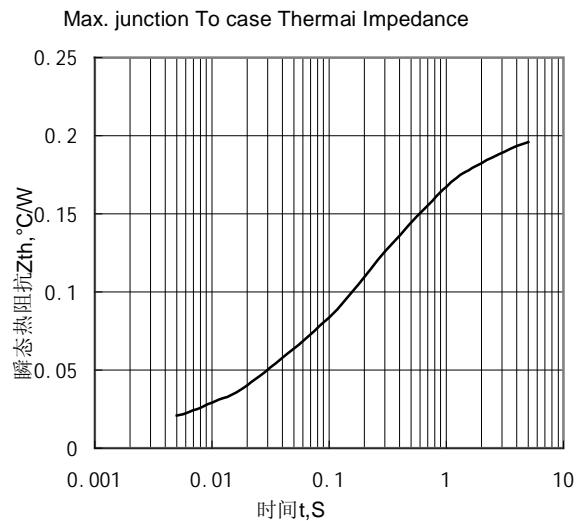


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

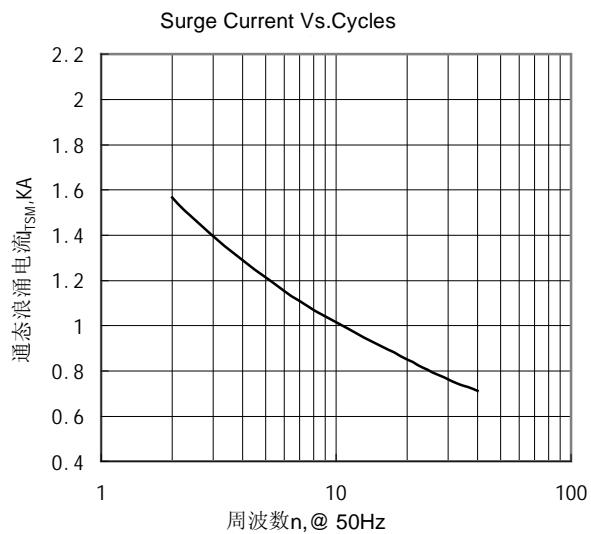


Fig.3 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

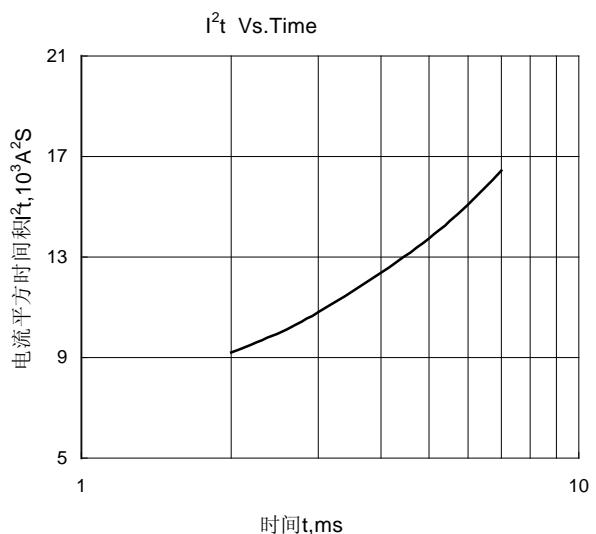


Fig.3 I^2t 特性曲线

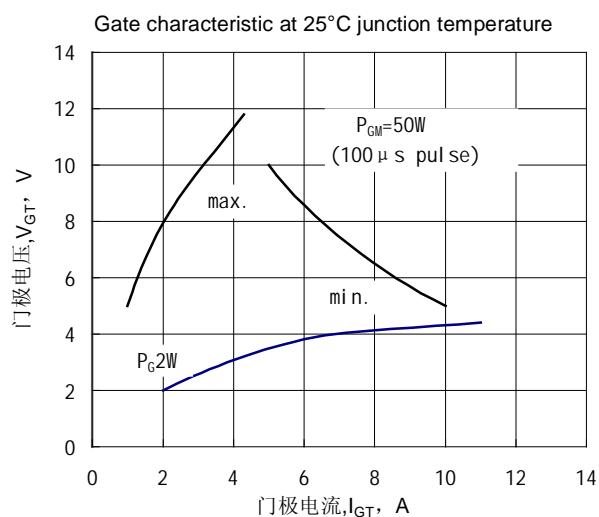


Fig.5 门极功率曲线

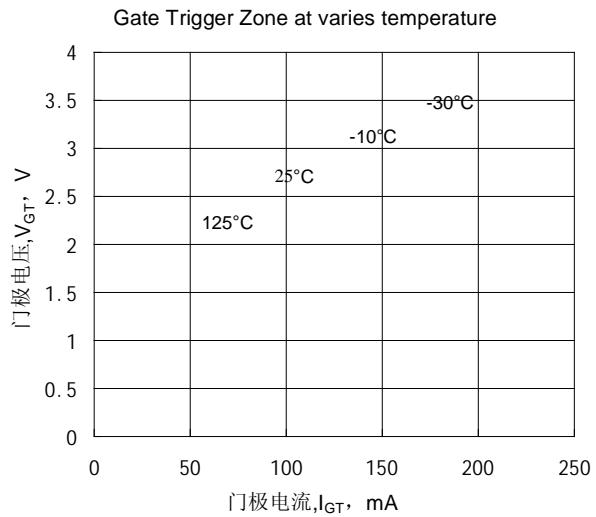
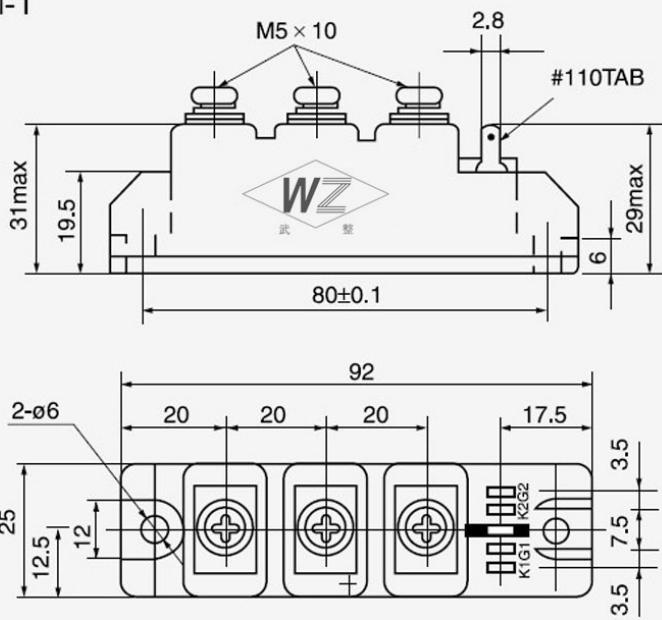


Fig.6 门极触发特性曲线

M-1



MTC/MDC 25-110A